

Подложки GaAs для LD

Параметр	Значение	Примечание
Тип проводимости	n-тип	
Метод роста	VGF	
Лигирующая примесь	Si	
Диаметр	2, 3 и 4 дюйма	слитки и заготовки также доступны
Кристаллографическая ориентация	(100)2 ⁰ /6 ⁰ /15 ⁰ off (110)	другие типы разориентации также доступны
Базовый срез по системе	EJ или US	
Концентрация носителей заряда	(0.4~2.5)E18/см ³	
Сопротивление при RT	(1.5~9)E-3 Ом*см	
Подвижность носителей заряда	1500~3000 см ² /В*с	
EPD	<500/см ²	
Лазерная маркировка	по запросу	
Качество поверхности	Двусторонняя/односторонняя полировка	
Толщина	220~350 мкм	
Epi-Ready	Да	
Упаковка	Индивидуальный контейнер или кассета	